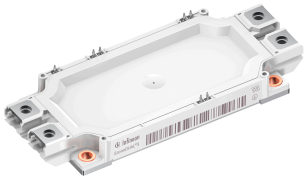
Final datasheet

EconoDUAL™3 模块 采用第四代沟槽栅/场终止 IGBT4 和发射极控制二极管 带有 PressFIT 压接管脚和温度检测 NTC / TIM

特性



- 电气特性
  - V_{CES} = 1700 V
  - $I_{C\ nom}$ = 600 A / I_{CRM} = 1200 A
  - 高电流密度
  - 低 V_{CEsat}
  - $T_{vj\ op}$ = 150°C
  - V_{CEsat} 带正温度系数
  - 可以从下面链接寻找适合的英飞凌驱动 IC https://www.infineon.com/gdfinder
- 机械特性
  - 高功率密度
  - 绝缘的基板
  - 标准封装
  - 预涂导热介质

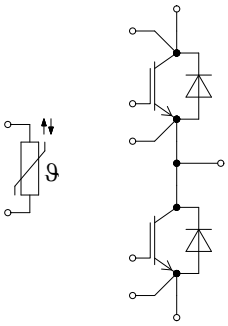
可选应用

- 大功率变流器
- 风力发电机

产品认证

- 根据 IEC 60747、60749 和 60068 标准的相关测试，符合工业应用的要求。

描述



内容

描述 1
特性 1
可选应用 1
产品认证 1
内容 2
1 封装 3
2 **IGBT, 逆变器** 4
3 二极管,逆变器 5
4 负温度系数热敏电阻 6
5 特征参数图表 7
6 电路拓扑图 10
7 封装尺寸 11
8 模块标签代码 12
修订历史 13
免责声明 14

1 封装

表 1 绝缘参数

特征参数	代号	标注或测试条件	数值	单位
绝缘测试电压	V_{ISOL}	RMS, f = 50 Hz, *t* = 1 min	3.4	kV
NTC 绝缘测试电压	$V_{ISOL(NTC)}$	RMS, f = 50 Hz, *t* = 1 min	3.4	kV
模块基板材料			Cu	
内部绝缘		基本绝缘 (class 1, IEC 61140)	Al_2O_3	
爬电距离	$d_{Creep\ nom}$	端子到基板, nom.	> 15	mm
爬电距离	$d_{Creep\ min}$	端子到基板, min.	14.7	mm
爬电距离	$d_{Creep\ nom}$	端子至端子, nom.	> 19.3	mm
爬电距离	$d_{Creep\ min}$	端子至端子, min.	19.3	mm
电气间隙	$d_{Clear\ nom}$	端子到基板, nom.	> 12.5	mm
电气间隙	$d_{Clear\ min}$	端子到基板, min.	12.5	mm
电气间隙	$d_{Clear\ nom}$	端子至端子, nom.	> 10	mm
电气间隙	$d_{Clear\ min}$	端子至端子, min.	9.6	mm
相对电痕指数	*CTI*		> 200	
相对温度指数 (电)	*RTI*	封装	140	°C

表 2 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
杂散电感,模块	L_{sCE}				20		nH
模块引线电阻,端子-芯片	$R_{CC'+EE'}$	T_H = 25 °C, 每个开关			1.1		mΩ
储存温度	T_{stg}			-40		125	°C
最高基板工作温度	T_{BPmax}					125	°C
模块安装的安装扭距	*M*	根据相应的应用手册进行安装	M5, 螺丝	3		6	Nm
端子安装扭矩	*M*	根据相应的应用手册进行安装	M6, 螺丝	3		6	Nm
重量	*G*				345		g

注: Storage and shipment of modules with TIM => see AN2012-07

2 IGBT, 逆变器

表 3 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
集电极－发射极电压	V_{CES}		T_{vj} = 25 °C	1700	V
连续集电极直流电流	I_{CDC}	$T_{vj\,max}$ = 175 °C	T_H = 50 °C	600	A
集电极重复峰值电流	I_{CRM}	t_p 受限于 $T_{vj\,op}$		1200	A
栅极－发射极峰值电压	V_{GES}			±20	V

表 4 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
集电极－发射极饱和电压	$V_{CE\,sat}$	I_C = 600 A, V_{GE} = 15 V	T_{vj} = 25 °C		1.95	2.30	V
			T_{vj} = 125 °C		2.35		
			T_{vj} = 150 °C		2.45		
栅极阈值电压	V_{GEth}	I_C = 24 mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25 °C		5.2	5.8	6.4	V
栅极电荷	Q_G	V_{GE} = ±15 V, T_{vj} = 25 °C			6.15		µC
内部栅极电阻	R_{Gint}	T_{vj} = 25 °C			1.2		Ω
输入电容	C_{ies}	f = 1000 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			48		nF
反向传输电容	C_{res}	f = 1000 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			1.55		nF
集电极-发射极截止电流	I_{CES}	V_{CE} = 1700 V, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C			1	mA
栅极-发射极漏电流	I_{GES}	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25 °C				100	nA
开通延迟时间(感性负载)	t_{don}	I_C = 600 A, V_{CC} = 900 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 1 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.200		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.210		
			T_{vj} = 150 °C		0.240		
上升时间(感性负载)	t_r	I_C = 600 A, V_{CC} = 900 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 1 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.070		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.080		
			T_{vj} = 150 °C		0.080		
关断延迟时间(感性负载)	t_{doff}	I_C = 600 A, V_{CC} = 900 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 1 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.620		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.750		
			T_{vj} = 150 °C		0.800		
下降时间(感性负载)	t_f	I_C = 600 A, V_{CC} = 900 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 1 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.110		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.160		
			T_{vj} = 150 °C		0.180		

(待续)

表 4 (续) 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
开通损耗能量 (每脉冲)	E_{on}	I_C = 600 A, V_{CC} = 900 V, L_σ = 35 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 1 Ω, di/dt = 6500 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		140		mJ
			T_{vj} = 125 °C		210		
			T_{vj} = 150 °C		225		
关断损耗能量 (每脉冲）	E_{off}	I_C = 600 A, V_{CC} = 900 V, L_σ = 35 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 1 Ω, dv/dt = 3000 V/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		115		mJ
			T_{vj} = 125 °C		180		
			T_{vj} = 150 °C		205		
短路数据	I_{SC}	$V_{GE} \leq$ 15 V, V_{CC} = 1000 V, $V_{CEmax}=V_{CES}-L_{sCE}*di/dt$	$t_P \leq$ 10 µs, T_{vj}=150 °C		2300		A
结－散热器热阻	R_{thJH}	每个 IGBT, Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material				0.0670	K/W
允许开关的温度范围	$T_{vj\,op}$			-40		150	°C

3 二极管,逆变器

表 5 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}		T_{vj} = 25 °C	1700	V
连续正向直流电流	I_F			600	A
正向重复峰值电流	I_{FRM}	t_P = 1 ms		1200	A
I2t-值	I^2t	t_P = 10 ms, V_R = 0 V	T_{vj} = 125 °C	32000	A^2s
			T_{vj} = 150 °C	30500	

表 6 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
正向电压	V_F	I_F = 600 A, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		1.80	2.20	V
			T_{vj} = 125 °C		1.90		
			T_{vj} = 150 °C		1.95		
反向恢复峰值电流	I_{RM}	V_{CC} = 900 V, I_F = 600 A, V_{GE} = -15 V, $-di_F/dt$ = 6500 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		580		A
			T_{vj} = 125 °C		650		
			T_{vj} = 150 °C		670		

(待续)

表 6 (续) 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
恢复电荷	Q_r	V_{CC} = 900 V, I_F = 600 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 6500 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		150		µC
			T_{vj} = 125 °C		250		
			T_{vj} = 150 °C		285		
反向恢复损耗（每脉冲）	E_{rec}	V_{CC} = 900 V, I_F = 600 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 6500 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		75		mJ
			T_{vj} = 125 °C		145		
			T_{vj} = 150 °C		165		
结－散热器热阻	R_{thJH}	每个二极管, Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material				0.107	K/W
允许开关的温度范围	$T_{vj\,op}$			-40		150	°C

4 负温度系数热敏电阻

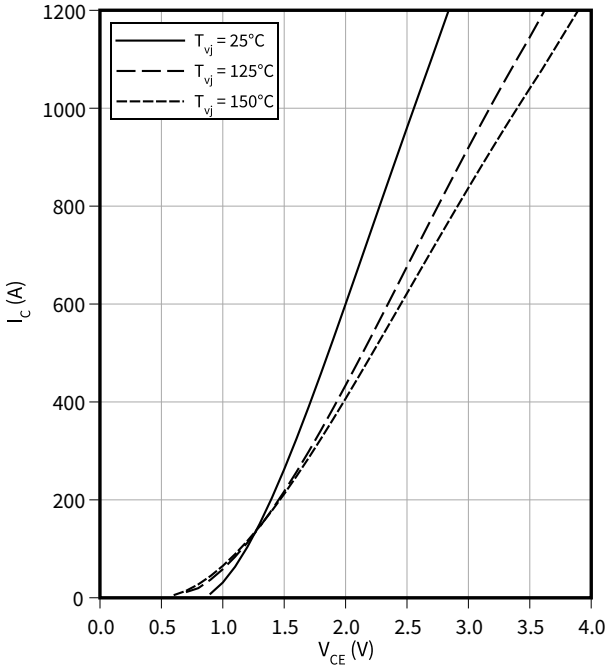
表 7 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
额定电阻值	R_{25}	T_{NTC} = 25 °C		5		kΩ
R_{100} 偏差	$\Delta R/R$	T_{NTC} = 100 °C, R_{100} = 493 Ω	-5		5	%
耗散功率	P_{25}	T_{NTC} = 25 °C			20	mW
B-值	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2-1/(298{,}15\ K))]$		3375		K
B-值	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2-1/(298{,}15\ K))]$		3411		K
B-值	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2-1/(298{,}15\ K))]$		3433		K

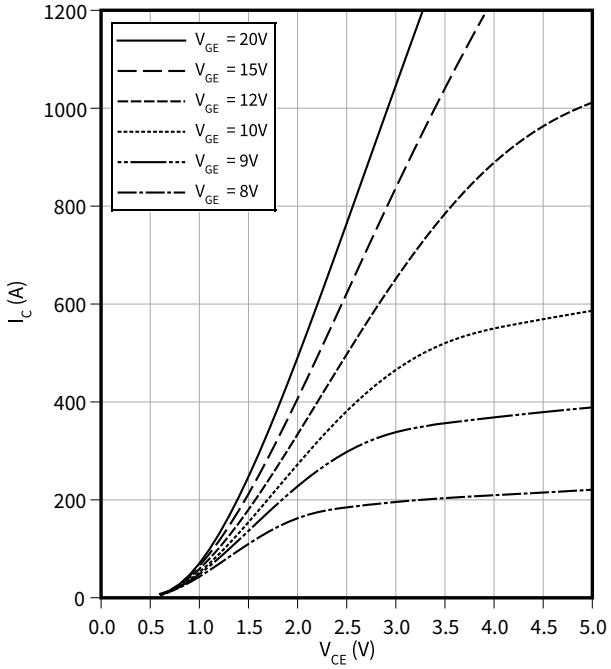
注: NTC 的具体参数分析请见 AN2009-10, 第 4 章

5 特征参数图表

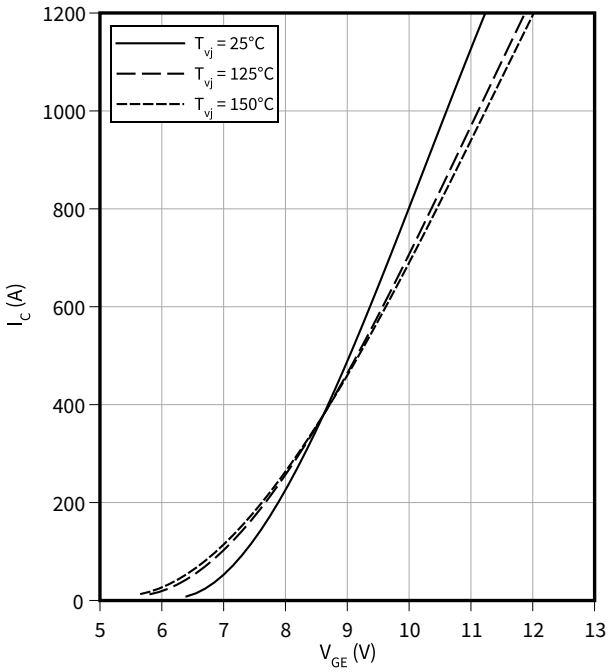
输出特性 （典型), IGBT, 逆变器
$I_C = f(V_{CE})$
V_{GE} = 15 V



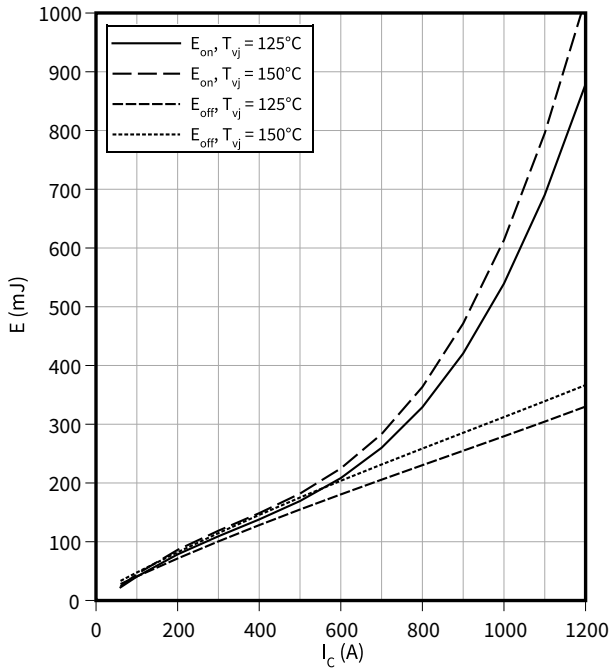
输出特性（典型), IGBT, 逆变器
$I_C = f(V_{CE})$
T_{vj} = 150 °C



传输特性 （典型), IGBT, 逆变器
$I_C = f(V_{GE})$
V_{CE} = 20 V



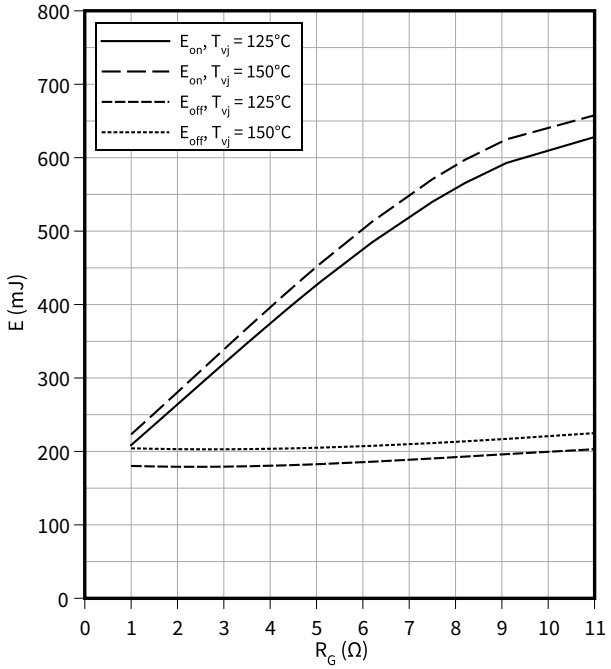
开关损耗 （典型), IGBT, 逆变器
$E = f(I_C)$
R_{Goff} = 1 Ω, R_{Gon} = 1 Ω, V_{GE} = ±15 V, V_{CC} = 900 V



开关损耗 （典型), IGBT, 逆变器

$E = f(R_G)$

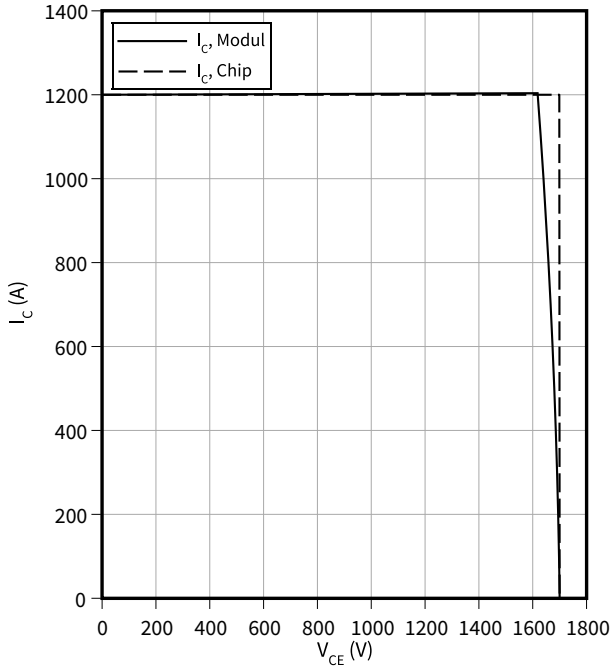
V_{GE} = ±15 V, I_C = 600 A, V_{CC} = 900 V



反偏安全工作区 （RBSOA）, IGBT, 逆变器

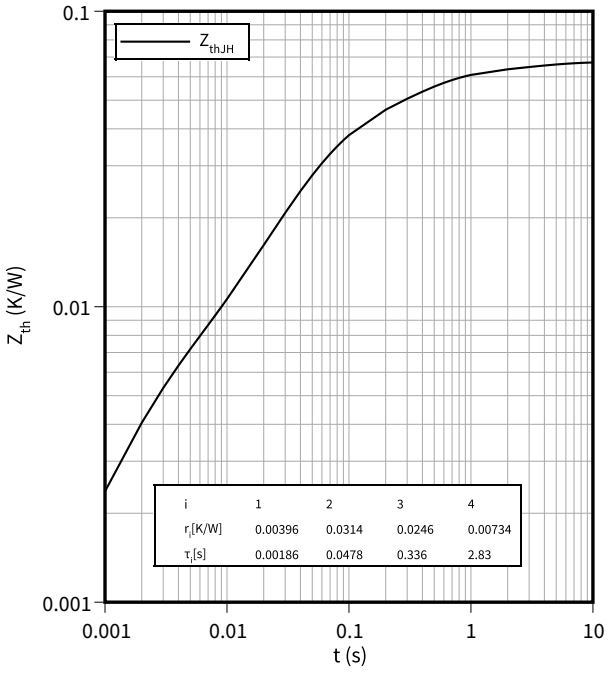
$I_C = f(V_{CE})$

R_{Goff} = 1 Ω, V_{GE} = ±15 V, T_{vj} = 150 °C



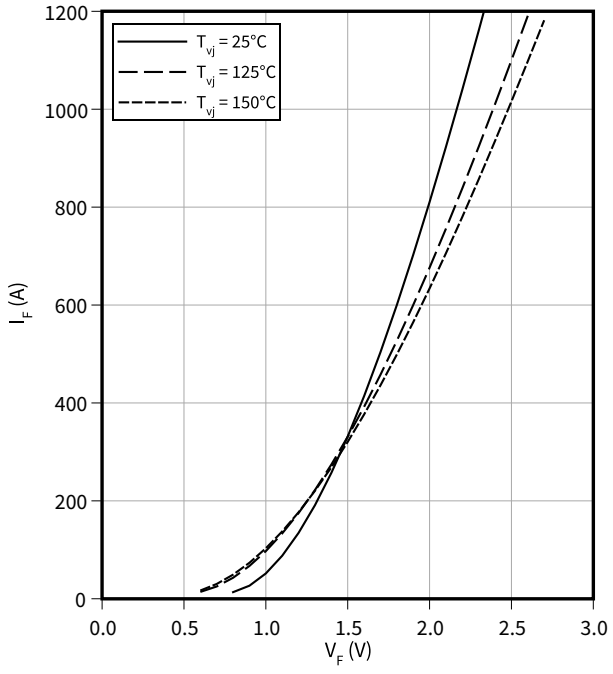
瞬态热阻抗, IGBT, 逆变器

$Z_{th} = f(t)$

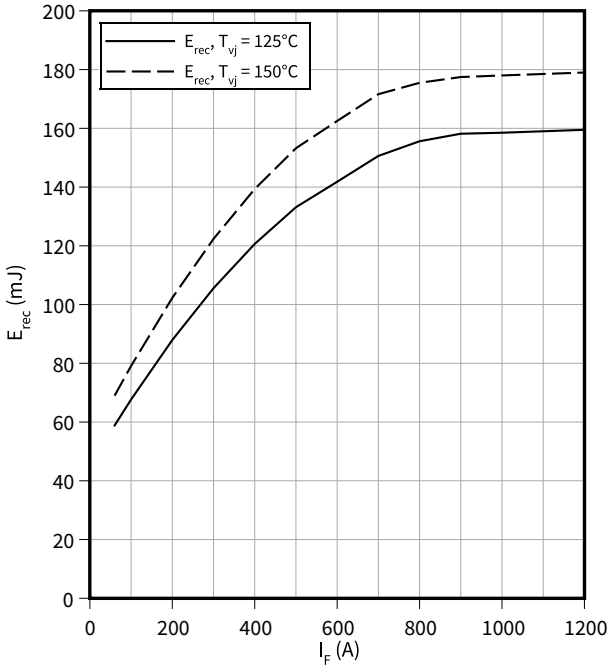


正向特性 （典型), 二极管,逆变器

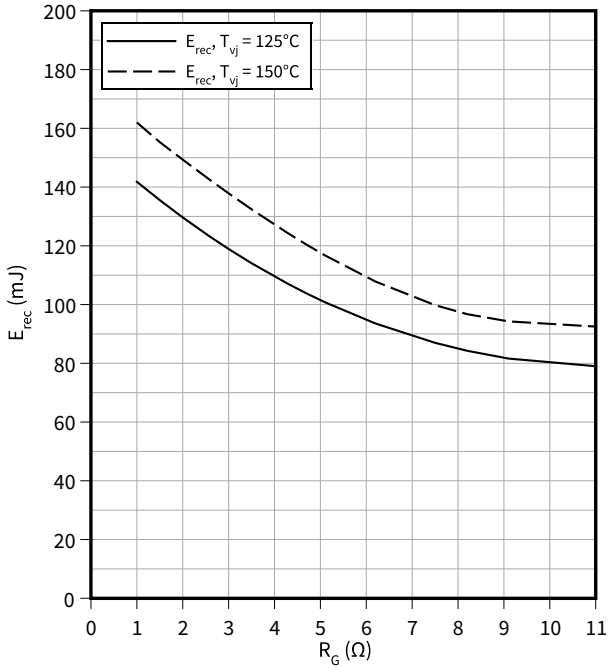
$I_F = f(V_F)$



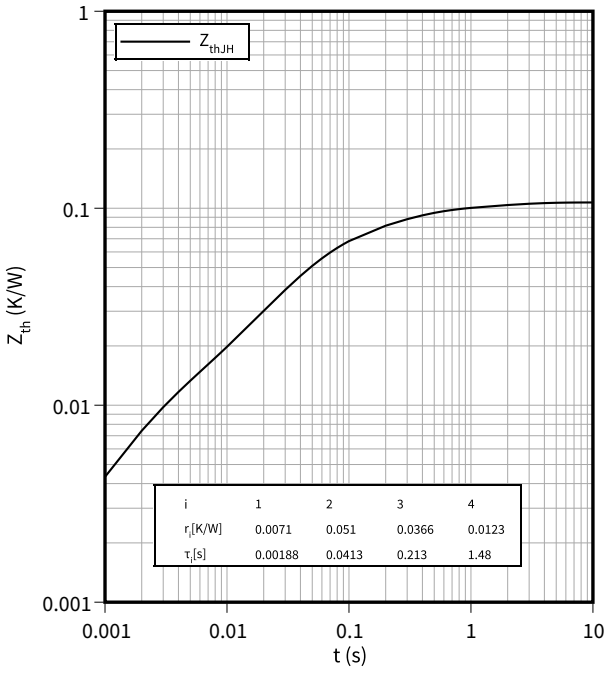
开关损耗 （典型), 二极管,逆变器
$E_{rec} = f(I_F)$
$R_{Gon} = 1\ \Omega$, $V_{CC} = 900$ V



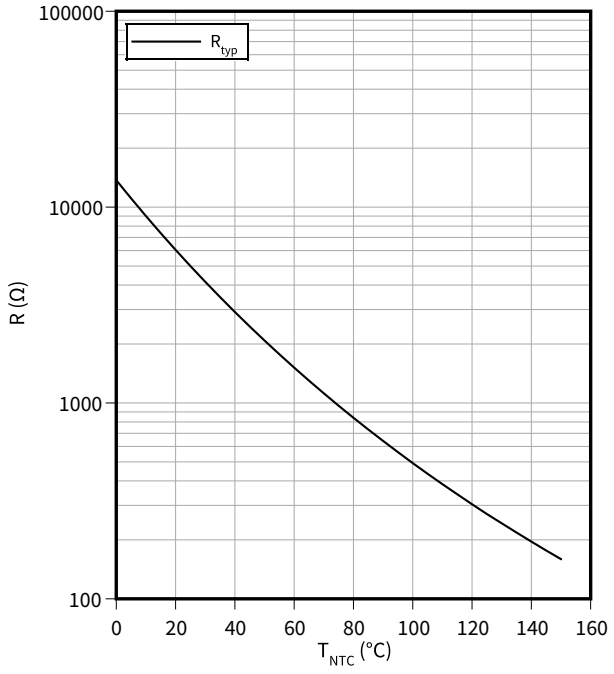
开关损耗 （典型), 二极管,逆变器
$E_{rec} = f(R_G)$
$I_F = 600$ A, $V_{CC} = 900$ V



瞬态热阻抗, 二极管,逆变器
$Z_{th} = f(t)$



温度特性, 负温度系数热敏电阻
$R = f(T_{NTC})$



6 电路拓扑图

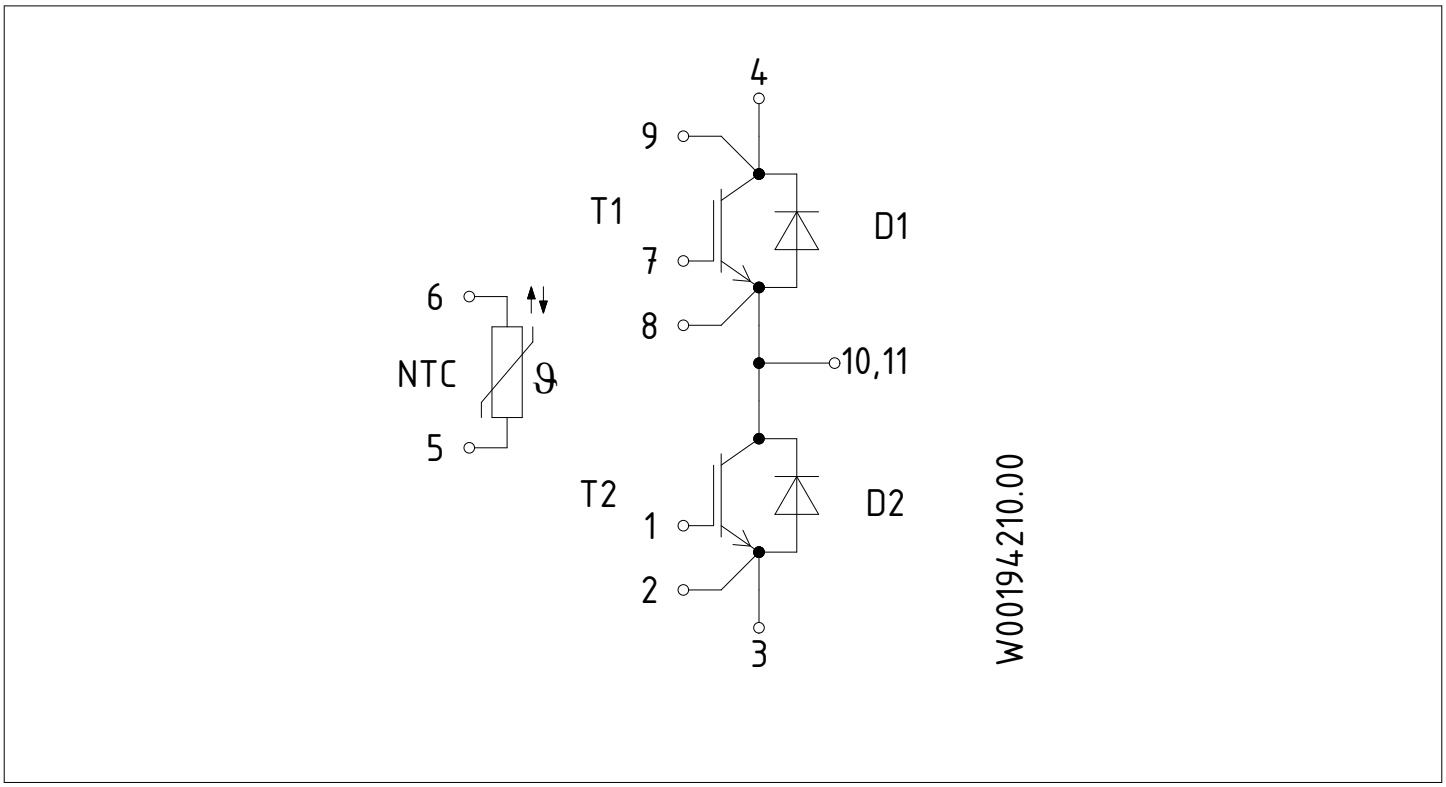


图 1

7 封装尺寸

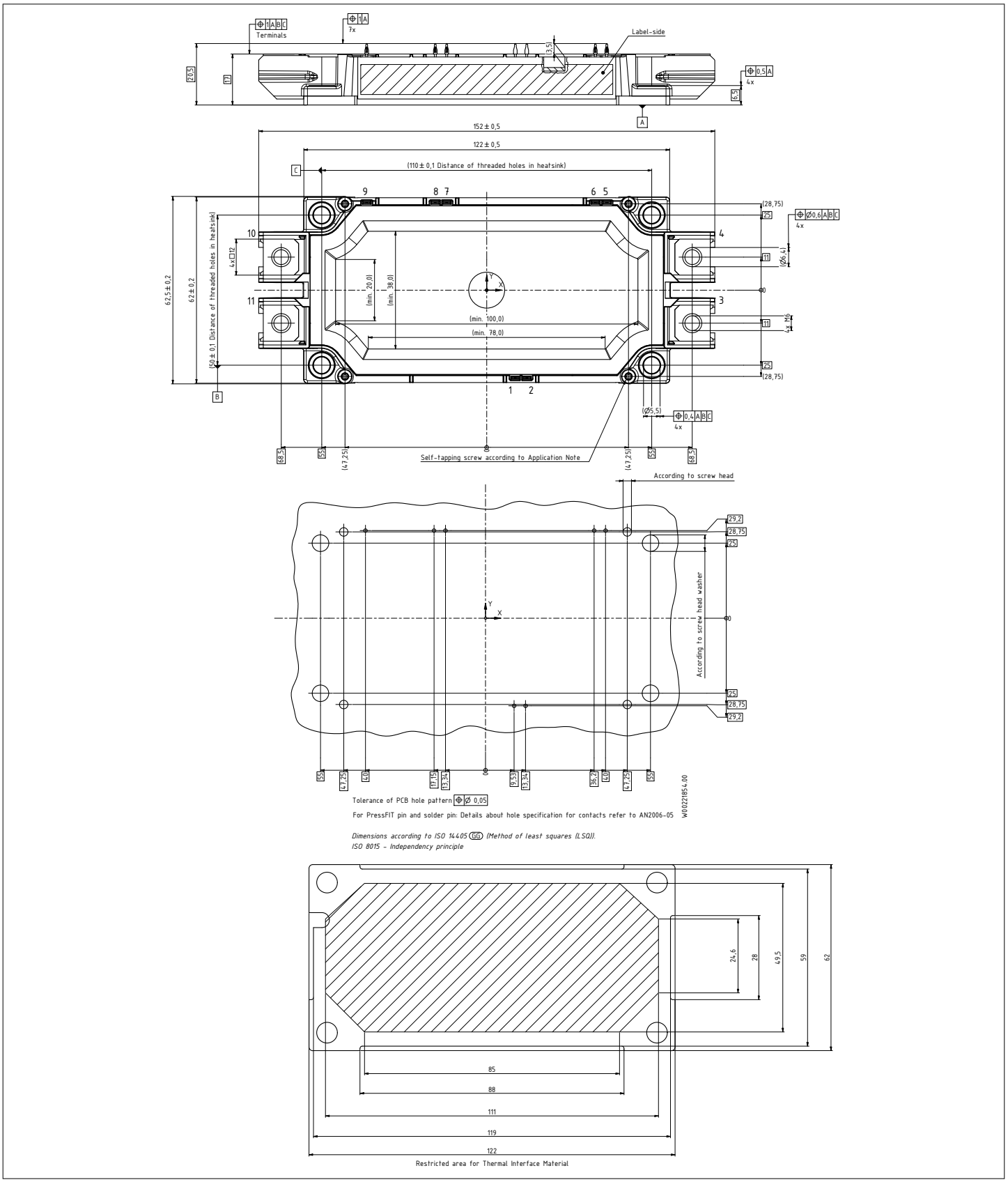

Terminals
Label-side
Self-tapping screw according to Application Note
According to screw head
According to screw head washer
Tolerance of PCB hole pattern Ø 0,05
For PressFIT pin and solder pin: Details about hole specification for contacts refer to AN2006-05
Dimensions according to ISO 14405 GG (Method of least squares (LSQ)).
ISO 8015 – Independency principle
Restricted area for Thermal Interface Material

图 2

8 模块标签代码

Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	*Content* Module serial number Module material number Production order number Date code (production year) Date code (production week)	*Digit* 1 –5 6 - 11 12 - 19 20 –21 22 –23	*Example* 71549 142846 55054991 15 30
Example	7154914284655054991530		7154914284655054991530

图 3

修订历史

修订版本	发布日期	变更说明
V1.0	2012-08-21	Target datasheet
V3.0	2017-07-19	Final datasheet
n/a	2020-09-01	Datasheet migrated to a new system with a new layout and new revision number schema: target or preliminary datasheet = 0.xy; final datasheet = 1.xy
1.10	2024-03-18	Final datasheet
1.20	2025-04-09	Final datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2025-04-09

Published by

Infineon Technologies AG

81726 Munich, Germany

© 2025 Infineon Technologies AG

All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-AAX175-004

重要提示

本文档所提供的任何信息绝不应当被视为针对任何 条件或者品质而做出的保证（质量保证）。

英飞凌对于本文档中所提及的任何事例、提示或者 任何特定数值及/或任何关于产品应用方面的信息均 在此明确声明其不承担任何保证或者责任，包括但 不限于其不侵犯任何第三方知识产权的保证均在此 排除。

此外，本文档所提供的任何信息均取决于客户履行 本文档所载明的义务和客户遵守适用于客户产品以 及与客户对于英飞凌产品的应用所相关的任何法律 要求、规范和标准。

本文档所含的数据仅供经过专业技术培训的人员使用。客户自身的技术部门有义务对于产品是否适宜 于其预期的应用和针对该等应用而言本文档中所提 供的信息是否充分自行予以评估。

警告事项

由于技术所需产品可能含有危险物质。如需了解该 等物质的类型，请向离您最近的英飞凌科技办公室 接洽。

除非由经英飞凌科技授权代表签署的书面文件中做 出另行明确批准的情况外，英飞凌科技的产品不应 当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后 当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后 领域。